# ESCOLA TÈCNICA SUPERIOR D'ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIO ENGINYERIA DE TELECOMUNICACIÓ DEPARTAMENT DE TEORIA DEL SENYAL I COMUNICACIONS MICROONES, TARDOR 2005-06

#### **EXAMEN FINAL**

PROFESSORS: A. AGUASCA, N. DUFFO, X. FÀBREGAS, L. PRADELL

Barcelona, 13 de gener de 2005

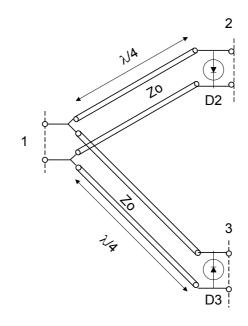
Data de publicació de notes provisionals:23 de gener Data límit per a al·legacions:25 de gener Data de publicació de notes definitives:27 de gener

Cal realitzar **només tres** dels quatre problemes proposats Temps: 3 hores. Comenci cada exercici en un full apart.

## PROBLEMA 1

El circuit de 3 portes de la figura és un commutador d'una entrada (porta 1) i dues sortides seleccionables (portes 2 i 3) mitjançant els diodes PIN (D2 i D3). Suposem que la sortida seleccionada és la 3 (D2 està en **ON** i D3 està en **OFF**), i que el diode en **ON** es comporta com un curtcircuit perfecte i el diode en **OFF** es comporta com una petita capacitat de valor **C**. Per a aquest estat del commutador es demana:

- a) És el circuit recíproc? És passiu sense pèrdues? Justifiqueu breument la resposta
- b) Calculeu els paràmetres S en reflexió del circuit (S<sub>11</sub>, S<sub>22</sub> i S<sub>33</sub>) referits a Z<sub>0</sub>.
- c) Calculeu els paràmetres S en transmissió del circuit (S<sub>ii</sub>, on j ≠ i). referits a Z<sub>o.</sub>
- d) Calculeu les pèrdues d'inserció (en dB) entre les portes 1 i 3 del circuit, a la freqüència de 3 GHz, suposant que  $Z_0$  = 50  $\Omega$  i C = 0.5 pF. Per al càlcul, suposeu que el generador connectat a la porta 1 és canònic, i que les portes 2 i 3 estan acabades amb  $Z_0$ .



## PROBLEMA 2

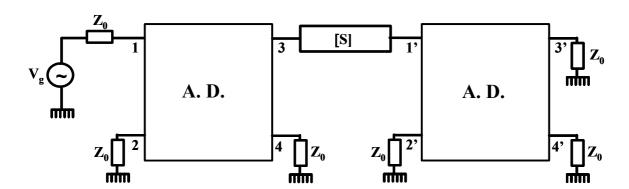
Es volen mesurar els paràmetres S referits a  $Z_0$ =50 $\Omega$  d'un dispositiu de dos accessos fent servir dos acobladors direccionals (A.D.) idèntics tal com indica la figura. Els paràmetres S dels acobladors direccionals es poden aproximar per la següent matriu:

$$[S_{AD}] \approx \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & \alpha \\ 0 & 0 & \alpha & -1 \\ 1 & \alpha & 0 & 0 \\ \alpha & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- a) Expresseu els paràmetres  $S_{11}$  i  $S_{21}$  del dispositiu en funció de les tensions dels ports  $V_2,\,V_4$  i  $V_4$
- b) Determineu la potència dissipada en el port 4' i el coeficient de reflexió vist des del port 1 quan la potència disponible del generador és de 20 dBm, l'acoblament dels

A.D. és de 15 dB i la matriu del dispositiu que es vol mesurar val  $\begin{bmatrix} S \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & j0.4 \\ j0.4 & 0.6 \end{bmatrix}$ 

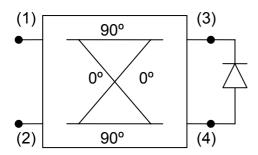
c) Si la càrrega  $Z_0$  del port 2 (primer A.D.) es substitueix per una càrrega  $Z_L$ =150 $\Omega$ , determineu el valor de la potència reflectida cap el generador ( $P_1^-$ ) i la potència dissipada en el port 2



## PROBLEMA 3

En un híbrid de 90° s'interconnecten els accessos 3 i 4 mitjançant un diòde PIN, de resposta ideal en les dues polaritzacions (fortament en directa i inversa).

- a) Descrigui el circuit equivalent de la xarxa per les dues possibles polaritzacions del diode (directe i inversa)
- b) Determini la matriu de paràmetres S de la xarxa equivalent de dos accessos resultant, per a les dues possibles polaritzacions del diode.
- c) Es connecta un generador canònic ( $Zg=Z_0=50\Omega$ ) a l'accés 1 de l'híbrid i una càrrega de referència a l'accés 2 del mateix. Raoni quina aplicació podria tenir la xarxa equivalent resultant?
- d) En el cas que el diòde es trobi connectat mitjançant línies de transmissió als accessos 3 i 4, trobi una longitud (en termes de la longitud d'ona) diferent de 0 que caldrà perquè el sistema presenti un comportament idèntic a l'aconseguit en l'apartat b.



## PROBLEMA 4

La matriu de paràmetres S d'un transistor referida a 50  $\Omega$  i a 12 GHz és:

$$S = \begin{bmatrix} 0.84 \angle 140^{\circ} & 0.07 \angle -93^{\circ} \\ 1.3 \angle -67^{\circ} & 0.57 \angle 30^{\circ} \end{bmatrix}$$

El coeficient de reflexió per a factor de soroll mínim Fmin és  $\Gamma_{\text{opt}}$ =0,73 $\angle$ -140°. Si es vol fer un disseny d'amplificador per a soroll mínim:

- a) Calculi el coeficient de reflexió de sortida del transistor.
- b) Calculi el guany unilateral en dB de l'amplificador dissenyat per a Fmin i amb adaptació a la sortida del coeficient calculat a l'apartat anterior. Compari'l amb el guany unilateral màxim.
- c) Trobi els valors de  $Z_{01}$  i  $Z_{02}$  de la xarxa d'entrada ( $\ell_1 = \lambda/4$  i  $\ell_2 = \lambda/8$ ).
- d) Trobi els valors de C i  $\ell_3$  de la xarxa de sortida.

